

2SD1595

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ(ダーリントン接続)
低周波電力増幅用, 低速度スイッチング用
工業用

NPN Silicon Epitaxial Darlington Transistor
Audio Frequency Power Amplifier and Low Speed Switching
Industrial Use

2SD1595は、低周波電力増幅用、低速度スイッチング用として開発されたモールドパワートランジスタで、OA・FA機器のパルスモータドライバ、プリンタドライバ、リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

特長/FEATURES

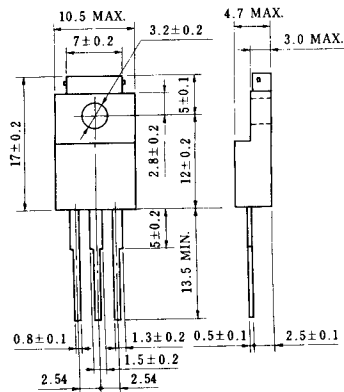
- 絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。
- サージ電圧吸収用C-B間ツェナーダイオードを内蔵しています。
- C-E間逆方向ダイオードを内蔵しています。
- コレクタ飽和電圧が低い。 $V_{CE(sat)}=1.5\text{ V MAX.} (@I_C=2\text{ A})$

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60±10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60±10	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	7.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	5.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	10	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	0.5	A
全損失	$P_T(T_c=25\text{ }^\circ\text{C})$	20	W
全損失	$P_T(T_a=25\text{ }^\circ\text{C})$	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

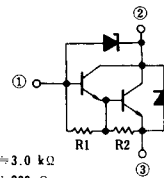
*PW ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 10 %

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



電極接続

- ① Base
- ② Collector
- ③ Emitter



$R_1 \approx 3.0\text{ k}\Omega$
 $R_2 \approx 300\ \Omega$